

Физика и техника полупроводников, 2025, том 59, выпуск 5

Международная конференция Физика А.СПб, 20-24 октября 2025 г., Санкт-Петербург

Лапушкин М.Н.

Адсорбция калия на поверхности $\text{Al}_{0.5}\text{Ga}_{0.5}\text{N}(0001)$

251

Казаков С.А., Дугин А.А., Гагиев Т.С., Гревцев М.А., Соколов А.В., Арефьева О.А., Шишкин А.Ю., Хворов В.Н.

Алгоритм селективного определения компонентов газовых смесей C_3H_8 - H_2 - CH_4 в исследовании температурной зависимости электропроводности полупроводникового сенсора на основе SnO_2

255

Клычков Н.А., Симаков В.В., Синев И.В.

Использование освещения для идентификации газовых сред полупроводниковыми сенсорами на основе оксида цинка

259

Карлина Л.Б., Власов А.С., Левин Р.В., Сошников И.П.

Самокаталитический рост GaInP -наноструктур на подложках кремния из паровой фазы: выбор состава источника и каталитических капель

265

Шершунова Е.А., Мошкунов С.И., Хомич В.Ю., Иголкин А.А.

Мощный импульсный повышающий преобразователь на нитрид-галлиевых транзисторах

270

Богданов А.А., Люблинский А.Г., Михайлов Е.М., Тубольцев Ю.В.

Установка для испытания чипов полевых транзисторов на устойчивость к лавинному пробую при работе на индуктивную нагрузку

274

Малевская А.Д., Минтаиров М.А., Евстропов В.В., Малевский Д.А., Салий Р.А., Калюжный Н.А.

Влияние резистивных параметров фотоэлектрических преобразователей на карты электролюминесценции и вольт-амперные характеристики

281

Поздеев В.А., Вячеславова Е.А., Михайлов О.П., Максимова А.А., Гудовских А.С., Уваров А.В.

Исследование влияния параметров центрифугирования и состава суспензии PEDOT:PSS на характеристики солнечных элементов b-Si/PEDOT:PSS

286

Шварц М.З., Емельянов В.М., Корниенко П.Д., Ларионов В.Р., Левина С.А., Минтаиров С.А., Нахимович М.В., Салий Р.А., Калюжный Н.А.

Метаморфные InGaAs/GaAs-гетероструктуры для радиационно стойких фотопреобразователей лазерного излучения

291

Мясоедов А.В., Мынбаева М.Г., Приображенский С.Ю., Амельчук Д.Г., Лебедев С.П., Лебедев А.А.

Применение композитных подложек 6H-SiC/3C-SiC(001) для выращивания кубического политапа карбида кремния методом сублимации

294

Маслова Н.А., Данилов Д.В., Вывенко О.Ф., Скуратов В.А., Володин В.А., Калядин А.Е., Соболев Н.А.

Комплексы собственных точечных дефектов в кремнии, сформированные в результате ионной имплантации ксенона высоких энергий и постимплантационных отжигов

298

Середин Б.М., Попов В.П., Малибашев А.В., Степченко А.Д., Заиченко А.Н.

Использование углерода для формирования дискретных зон на основе алюминия при их термомиграции в кремнии

302

Вывенко О.Ф., Гогина О.А., Петров Ю.В., Убийвовк Е.В., Аргунова Т.С., Нагалюк С.С.

Дислокационная структура индентированных объемных кристаллов AlN

306

Бекман А.А., Мельниченко И.А., Шерняков Ю.М., Корнышов Г.О., Гордеев Н.Ю., Паюсов А.С., Симчук О.И., Ткач Ю.С., Максимов М.В.

Спектральные и пространственные характеристики излучения торцевых лазерных диодов на основе квантовых ям InGaAs/GaAs со сверхшироким волноводом

310